第 24 卷第 11 期 2008 年 11 月

POLYMERMATERIALSSCIENCEANDENGINEERING

PET 基纳米 Ag 薄膜形貌与导电及电磁屏蔽 性能的分形表征

王鸿博,赵晓燕,魏取福,高卫东

(江南大学生态纺织科学与技术教育部重点实验室,江苏 无锡 214122

摘要:采用磁控溅射法在 PET 非织造布上制备了不同厚度的纳米结构 Ag 薄膜,用高度相关函数法对薄 膜的原子力显微镜(AFM)图像进行分形维计算,用 AFM 分析不同厚度纳米结构 Ag 薄膜形貌及粒径的 变化;用网络测试仪测试了不同厚度样品的电磁屏蔽效能。结果表明,随着薄膜厚度的增加,薄膜表面 质量提高,分形维增大;电磁屏蔽效能也随分形维的增大而增加。可以认为,分形维能有效地表征薄膜 的表面形貌,分形维与导电及屏蔽效能存在明显的对应关系,并可以用分形维优化磁控溅射的工艺条 件。

关键词:分形:纳米银薄膜;表面形貌;屏蔽效能;磁控溅射
中图分类号:TB383
文献标识码:A
文章编号:1000-7555(2008)11-0119-03

以纺织材料作为基材沉积纳米 Ag 薄膜可 制得理想的功能纺织材料。纺织材料表面纳米 银镀层功能化,可用于开发纤维太阳能电池、纺 织电磁波屏蔽、纤维传感器、抗菌纺织面料和医 用敷料等^[1~5]。目前国内外制备纳米 Ag 薄膜 的方法有溶胶-凝胶法、CVD 法、溅射法等。溶 胶-凝胶法制备纳米 Ag 薄膜,工艺简单易行,但 薄膜不够均匀、致密、附着力差、膜层容易脱落、 难以适应循环应用。化学镀层技术^[5]也被用 来在纺织材料表面沉积银镀层,但化学镀层是 在反应液中进行,会产生加工污染。而用磁控 溅射法制备薄膜,膜层均匀、致密,性能优良,薄 膜与基材附着牢靠,因此在导电、抗静电、防辐 射、抗菌等方面的应用有着明显的优势。本文 以 PET 非织造布表面沉积纳米 Ag 薄膜形貌的 原子力显微镜(AFM)图像进行分形维计算,重 点研究分形维数与薄膜形貌、薄膜颗粒直径、方 块电阻和电磁屏蔽效能之间的联系。

1.1 材料及仪器

涤纶非织造布(100 g/m²),制备成外径 115mm、内径 12mm 的圆环状试样;JZCK-420B 高真空多功能磁控溅射设备(沈阳聚智科 技公司);CSPM4000 原子力显微镜(广州本原 科技公司);SX-1934 四探针测试仪(苏州百神 科技公司);8753ES 矢量网络分析仪(Agilent 公司)。

1.2 基材的预处理及纳米银薄膜的制备

为提高银膜在基材表面的附着性能,基材 采用丙酮结合超声波进行清洗。

在磁控溅射仪中用高纯金属 Ag 靶材,对 PET 纺粘非织造布基材沉积 Ag 薄膜,靶与衬 底间距为 60mm 。制备试样的条件:功率 120 W、溅射气压为 3Pa; 工作气体为 Ar, 气流速度 20SCCM; 溅射电压 600V、电流 0.35A 。

1.3 薄膜形貌表征及性能测试

薄膜形貌用原子力显微镜表征;薄膜方块 电阻用四探针测试仪测试;薄膜电磁屏蔽效能 测试依据 ASTMD4935-99 进行,材料屏蔽效

1 实验部分

收稿日期:2007-08-08; 修订日期:2007-10-30

基金项目:教育部博士点专项基金项目(20060295005);生态纺织教育部重点实验室开放基金(LET0618) 联系人:王鸿博,主要从事功能纺织材料研究, Email:wxwanghb@163.com 能(SE)由下式得出:

$$SE (dB) = 101 g(P_1/P_2)$$

$$\vec{x} SE (dB) = 201 g(V_1/V_2)$$
(1)

式中: *SE* — 屏蔽效能,单位 dB; P_1 — 有屏 蔽材料时的接收功率(W); P_2 — 无屏蔽材料 时的接收功率(W); V_1 — 有屏蔽材料时的接 收电压(V); V_2 — 无屏蔽材料时的接收电压 (V)。

1.4 分形维计算

自 Yehoda 和 Messier 等人^[6] 证明薄膜表 面具有分形特征以来,分形学已经成为研究薄 膜表面形貌的重要工具。目前,分形理论研究 薄膜表面形貌的主要工具有扫描电镜 (SEM)^[7],X 射线仪^[8],扫描探针显微镜 (SPM)^[9]等。在分形维计算方法中,高度相关 函数法由于适合计算具有自仿射分形特征的薄 膜表面,且物理意义明确,分形维计算简单,表 征直观,因此得到越来越多的应用。所有的粗 糙表面在垂直方向均表现波动性,可利用表面 粗糙度定性描述波动特征。表面粗糙度 W(r) 为表面高度 z(r)变化的均方差,即:

 $W(r) =<[z(r) -< z>]^2 > 1/2$ (2)

 这里 z(r) 为 r (x, y) 坐标位置处的表

 面高度, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$,符号 <> 表示求平均。

 通过式(2)看出,表面粗糙度 W(r)描述了表面

在垂直方向的随机波动程度。为了描述表面上 相距为 r 的两个点之间的关系 ,定义一个高度-高度相关函数 :

 $G(r) = < [z(r) - z(O)]^2 >$ (3)

对于一个自仿射分形结构,高度-高度相关 函数具有下列关系式:

$$G(r) = \begin{cases} r^{2a} & (r \ll) \\ 2 W^{2}(r)(-r \gg) \end{cases}$$
(4)

式中: ——与表面平行的相关长度, ——表面粗糙度指数。分形维数 D 与 之间 关系为 D = d- ,其中 为欧式空间维数,对 于薄膜表面来说 d = 3 。根据式(4)可知,当 r《 时,薄膜表面表现出标度不变性,G(r)与 r成幂律关系。因此只要能求出不同 r下的高 度-高度相关函数 G(r),就可以通过 $\ln G(r)$ - $\ln(r)$ 的直线斜率2 计算出分形维数 D。Tab. 1 给出了不同厚度薄膜的有关性能及分形维 数。

Tab.1 Propertiesandfractalofsilverfilmwith

Thickness(nm)	25	50	75	100	
AverageDiameter (nm)	47.9	56	62.4	65.5	
Squareresistance (m)		1531	642	455	
ShieldingEffectiveness (dB(1200MHz))	3.5	23.6	25.3	29.8	
Fractal	2.31	2.39	2.44	2.48	

(a) 25nm (b) 50nm (c) 75nm (d) 100nm Fig.1 AFMina gesofsilverfilmsofdifferentthicknesses(scannin gscale:2500nm ×2500nm)

2 结果与讨论

2.1 纳米结构 Ag 薄膜表面形貌与分形维

通过膜厚仪控制,制备了不同厚度的纳米 银薄膜,Fig.1 为不同厚度银薄膜的 AFM 形貌 图。可以看出,银薄膜由颗粒状粒子组成,粒子 的大小有较好的均匀性,在扫描范围内仅有少 量的尺寸较小的团聚。Ag 颗粒都均匀地覆盖 在基材纤维表面,粒子间隙较小,分布较均匀。 实际上,薄膜的表面形貌随着膜厚的增加有着 明显区别,在膜厚为 25nm 时,见 Fig.1 (a),薄 膜处于生长初期,还未形成连续结构,表面缺陷 较多,起伏较大;随着膜厚的增加,见 Fig.1 (b)、Fig.1 (c)、Fig.1 (d),薄膜继续生长,表面 逐渐形成连续结构,其致密度逐渐改善,生长更 均匀,缺陷减少。从 Tab.1 看出,分形维随膜 厚的增加而变大,这与薄膜表面质量的变化是 一致的。也就是说,分形维大小与薄膜表面质 量具有对应关系,分形维越大,表明薄膜表面复 杂程度越高,凹凸、褶皱越多,表面质量越好。 因此,用分形维能较好地表征薄膜的表面质量。 2.2 纳米结构 Ag 薄膜颗粒直径与分形维

通过 AFM 自带软件,测试了薄膜银颗粒 直径(如 Tab.1)。可以看出,颗粒直径随着膜 厚的增加而增加,与分形维的变化一致。也就 是说,薄膜的颗粒直径变化与薄膜表面质量具 有对应关系。由于磁控溅射银薄膜的生长类型 属于核生长型,到达基材的原子首先凝聚成核, 后续飞来的原子不断集聚在核附近使核在三维 方向上不断成长,经过小岛阶段、网络阶段之后 形成连续薄膜,因此在薄膜厚度较小时,颗粒直 径不断增大;同时随着溅射时间的增加,从靶中 溅射出来的银原子数量增多 沉积到基材表面 的 Ag 原子/ 原子团密度流随之增加,导致颗粒 生长速度加快,来不及扩散,从而使颗粒直径增 大。后续原子在不断集聚在原先的核上使之增 大之外,还会在沟道之间形成新的核,后续的原 子也集聚在新形成的核上,使新核不断长大,覆 盖住原先颗粒的一部分,如此此起彼伏,不断重 复,薄膜越来越致密,颗粒大小越来越均匀。

2.3 纳米结构 Ag 薄膜导电性能与分形维

不同厚度薄膜的方块电阻(R(m))如 Tab.1。方块电阻随着膜厚的增加而下降,平 均方块电阻的范围从 1531m 到 64m 变化, 与分形维的变化相反。也就是说,薄膜的方块 电阻的变化与薄膜表面质量具有对应关系。考 虑到纺织纤维的重叠纠结,纺织品的表面起伏 较大,基底表面为粗糙不平结构,并结合 AFM 图像的观察,可以认为纺织基材表面薄膜是由 大量岛状的团族组成,这些相邻而不相连的团 族会形成金属-绝缘体-金属结,每个结有一个 势垒,这些结构复杂的串并联构成一个复杂的 无规网络。薄膜的导电性能与这些结的数量及 结的势垒密切相关。随着溅射时间延长,膜厚 增加,薄膜结构变得更复杂,缺陷和小岛数量不 断增加,结的数量也随之增加,小岛间距离变 小,导致结的势垒提高,因此方块电阻下降。 纳米结构 Ag 薄膜电磁屏蔽性能与分形 2.4

维

7

不同厚度薄膜的电磁屏蔽性能见 Tab.1。 屏蔽性能随着膜厚的增加而明显增加,与分形 维的变化一致。即薄膜的屏蔽性能与薄膜表面 质量具有对应关系,因此同样可以用分形维的 变化表征薄膜的屏蔽性能。PET 基银膜复合 材料主要通过反射和吸收来实现对电磁波的屏 蔽,反射损耗与金属镀层的电导率和电磁波频 率有关,而吸收损耗除与镀层的电导率和电磁 波频率有关外,主要受镀层厚度的影响。在低 频时,材料的屏蔽效能主要来源于反射,导电性 越好,反射越强,在高频时,则主要取决于电磁 波在材料内部传播时的吸收损耗。测试结果表 明,银膜厚度为 25nm 的复合材料,由于连续 性差,薄膜的导电能力差,而且薄膜的厚度小, 因此在低频和高频段织物的屏蔽效能都较差: 而当厚度达到 50nm 以上,在织物表面可以形 成连续的薄膜并且具有良好的导电性能时,织 物的屏蔽效能迅速增强,其屏蔽率一般可达到 20dB 以上。

3 结论

采用磁控溅射法在 PET 非织造布上制备 了不同厚度的纳米结构 Ag 薄膜,其表面形貌 随膜厚的增加有显著变化,这主要由基材结构 以及薄膜的生长阶段等离子体环境不同所导 致;薄膜的导电性能及屏蔽效能都随膜厚的增 加而逐渐增大,分形维可以较好地描述薄膜表 面形貌,分形维越大,薄膜表面质量越高,分形 维越小,表面质量越差。分形维与薄膜表面的 导电性、颗粒直径、屏蔽性能均具有对应关系。 参考文献:

- [1] BANCHIL.RivistaDellaTechnolo gie,2001,3:62 -69.
- [2] GOULDP.MaterialsToda y,2003,6 (10) :38 -43.
- [3] DOWLINGDP,DONNELLYK.TheSolidFilms, 2001,389:602 -606.
- [4] SANTSB.Scri ptaMaterrialia,1999,4 (12):1333 -1339.
- JIANGSQ,NEWTONE,YUENCWM, et al.J.A ppl.Pol ym.Sci.,2005,96:919 -926.
- [6] YEHODAJE, MESSIERR.J.A ppl.Ph ys., 1985, 58: 3739-3746.
- [7] ZHENGZS,QUXH,LIYP.Trans.NonferrousMet. Soc.China,2003,13 (5) :1112 -1118.
- [8] 邵元智.中国有色金属学报,2004,14 (4):574-579.
 SHAOYZ.TheChineseJournalofNonferrousMetals,
 2004,14 (4):574-579.
- [9] ALMQVISTN.Surf.Sci.,1996,355:221 -228. (下转第 125 页。tobecontinuedon p.125)

1997,38:5565 -5571. [10] ROBERTSONJE,WARDTC,HILLAJ.Pol ym., 2000,41 (16) :6251 -6262.

Miscibilit yandMechanicalPro pertiesofNovelPPESK/PSFBlends

ZHANGXin -tao,LIAOGon g-xiong,DONGLi -ming,XUYa -juan,FENGXue -bin,JIANXi -gao (Department of Polymer Science and Materials, Dalian University of Technology, Liaonin g High Performance Polymer Engineering Research Center, Dalian 116012, China)

ABSTRACT:Bisphenol-A polysulfone (PSF) asamodifierwereusedtoim prove poly (phthalazinone ethersulfoneketone) s (PPESK) resinmelt processing properties.WiththeincreaseofPSFcom ponents,thePPESK/PSFblendsmelt processabilitieshavebeenim provedsi gnificantly. The glasstran sitiontem perature (T_g) and the mor phology of the blends were investi gatedb ydifferentialscannin g calorimetry (DSC) and scannin gelectronmicrosco py (SEM). The results show that the two T_g of PPESK/PSFblendshaveshiftedsli ghtl ycom paredtothetwo $T_{\rm g}$ of the pure polymer. The blends sec tionmor phologieswerehomo geneousandtheinter phasewasratherambi guous.Alltheseresultsindi catetheblendsare partiall ymiscibles ystem. Usin guniversaltestin gmachinetotestitsmechanical properties, the results show that with the increase of PSF, the mechanical stren gthexhibitsdownward trend, but the content of less than 40% PSF is still maintain in garelativel yhi ghintensit y.

Keywords: poly (phthalazinoneethersulfoneketone) s; polysulfone; miscibilit y; mechanical stren gth

(上接第 121 页。continuedfrom p.121)

SufaceMor phologiesofPETNonwovensDe positedwithNanostructuredSilver FilmsandTheirFractalCharacterizationsofConductionsandElectroma gnetic ShieldingPro perties

WANGHon g-bo,ZHAOXiao -yan,WEIQu -fu,GAOWei -dong
(Key Laborator y of Science & Technology of Ecσ Textiles, Ministry of Education, Jian gnan University, Wuxi 214122, China)

ABSTRACT: Tostud ythesurfacemor phologiesandelectroma gneticshieldin g propertiesofPETnon wovensde positedwithnanostructuredsilverfilms,ma gnetrons puttercoatin gtechnolo gywasa pplied $tos\ putternanos tructured silver films of different thicknesses on PET nonwovens. Atomic Force Minimum transformation of the second second$ croscope (AFM) imagesofsam pleswereem ployedtocalculatethefractaldimensionb yhei ghtcorrela tionfunction, and which we real so a ppliedtoanal yzethesurfacemor phologyofthesilverfilmandthe grainsizesofthesilver particles.Theelectroma gneticshield propertiesoffilmswithdifferentthick yzer.Thetestresultsindicatethatthefilmsurface nessesweretestedb ythenetworkanal quality and fractaldimensionincreaseasthefilmthicknessesadded;meanwhile.theelectroma gneticshieldin g propertiesalsoenhance. Therefore, it is believed that a obvious coincidence relation of fractal dimen sionandconductivewithelectroma gneticshieldin g propertiesisexisted.Fractaldimensioncancharac terizethefilmsurfacemor phologyeffectivel y,andwhichcanalsobeem ployedtoo ptimizethetechni cal parameterofma gnetrons putter.

Keywords:fractal;nanostructuredsilverfilm;surfacemor phologies;shieldin g properties;ma gnetron sputter